

[16016]

極微小デバイスへの放射線照射損傷機構の解明 Elucidation of radiation damage mechanisms for micro devices

学術論文（査読あり）

- [1] Authors, “Title,” Journal **Volume**, pp (Year).
- [2] 著者名, 「論文題名」, 論文誌 号数, ページ (発刊年) .
- [3]

学術論文（査読なし）

- [1]
- [2]
- [3]

卒業論文

- [1] 米本悠人, 「Fin, GAAFET の電子線照射による劣化特性の評価」, 熊本高等専門学校 情報通信エレクトロニクス工学科 卒業論文, (2017) .
- [2] 清水昇, 「フラーレンを用いた有機ショットキーダイオードの作製と耐環境評価」, 熊本高等専門学校 情報通信エレクトロニクス工学科 卒業論文, (2017) .
- [3] 松崎光成, 「熱処理法を用いた SOI FinFET の電子線照射による劣化機構の検討」, 熊本高等専門学校専攻科 電子情報システム工学専攻 特別研究論文, (2017) .
- [4] 井澤桃香, 「有機ショットキーダイオードの作製と耐放射線性の評価」, 熊本高等専門学校専攻科 電子情報システム工学専攻 特別研究論文, (2017) .

国際会議

- [1] K. Okamoto, K. Tomouchi, E. Murakami, K. Takakura, I. Tsunoda, “Enhancement of solid-phase crystallization of amorphous Ge on insulating substrate by electron stimulated nucleation,” Extended abstracts of 35th Electronic Materials Symposium, pp. 171-172 (2016).
- [2] K. Iseri, M. Matsuzaki, M. Yoneoka, I. Tsunoda, K. Takakura, E. Simoen, C. Claeys, “Study of mobility enhancement at the channel of Gate-All-Around nMOSFETs,” Extended abstracts of 35th Electronic Materials Symposium, pp.213-214, (2016).

国内会議

- [1] 登田晃浩, 松崎光成, 井芹健人, 米本悠人, 米岡将士, 角田功, 高倉健一郎, 「Fin, GAAFET の対放射線性評価」, 平成 28 年度原子力人材育成フォーラム, (2016) .
- [2]

招待講演等

- [1]
- [2]

解説・記事等

- [1]
- [2]

新聞発表等

- [1]
- [2]

特許等

- [1]
- [2]